

## รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการการสังเคราะห์ที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสารกึ่งตัวนำ ไฟฟ้า CZTS ด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟเพื่อนำไปใช้สำหรับเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดโค้งงอได้ (Fast and Green Synthesis of CZTS by Microwave Irradiation Applied for Flexible Solar Cell)

หัวหน้าโครงการวิจัย

ดร. นรวิชญ์ ไกรนรา

โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสโครงการ 256109A1080049 สัญญาเลขที่ ๒๐๙/๒๕๖๑

## รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการการสังเคราะห์ที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า CZTS ด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟเพื่อนำไปใช้สำหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิด โค้งงอได้

(Fast and Green Synthesis of CZTS by Microwave Irradiation Applied for Flexible Solar Cell)

หัวหน้าโครงการวิจัย

ดร. นรวิชญ์ ไกรนรา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กันยายน พ.ศ. 2562

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงาน คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สัญญา 209/2561

Acknowledgement

This work was financially supported by the Research Grant of Burapha University through National Research Council of Thailand (Grant no. 209/2561)

## บทคัดย่อ

การสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ (Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>, CZTS) ในระบบปิดภายใต้การ ฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 100, 200 และ 300 วัตต์ ในระยะเวลา 5 นาที โดยผลิตภัณฑ์มีการ เปรียบเทียบการใช้สารตั้งต้น 2 ตัวดังต่อไปนี้ คือ thiourea และ Na<sub>2</sub>S โดยมี Glutaraldehyde เป็น สารควบคุมขนาดอนุภาค พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นผงสีดำแกมเขียวร้อยละผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง 66.94 – 105.76% และผลการทดลองพบว่าที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ มีร้อยละของผลิตภัณฑ์สูงที่สุดเท่ากับ 75.01 และ 105.76% ของอนุภาคที่ใช้ thiourea และ Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้นตามลำดับ อนุภาคที่สังเคราะห์ได้ ทั้งหมดถูกนำไปวิเคราะห์ลักษณะอนุภาคและองค์ประกอบธาตุด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด พบว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเป็นโครงผลึกแบบแผ่นซ้อนทับกัน CZTS ที่มี อัตราส่วนโมล เท่ากับ 2:1:1:4 สามารถสังเคราะห์ได้โดยใช้ thiourea เป็นสารตั้งต้น

คำสำคัญ คอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ ไมโครเวฟ ไทโอยูเรีย โซเดียมซัลไฟด์

#### Abstracts

Closed system synthesis of CZTS particles under 100, 200 and 300 watt microwave irradiation was studied for 5 minutes. The products obtained by thiourea and Na<sub>2</sub>S as reactants were compared. Glutaraldehyde were used as particle size controller. %Yield of Greenish black powder CZTS particles was obtained between 66.94% to 105.76%. It was found that the highest %yield of synthesis under 300 watt using thiourea and Na<sub>2</sub>S are 75.01% and 105.76%, respectively. The characteristics of CZTS particles were obtained by scanning electron microscope (SEM). The results found that the CZTS particles show as stacking of sheet.  $Cu_2ZnSnS_4$  semiconductors were synthesized by 300W microwave irradiaton using thiourea as reactants.

คำสำคัญ คอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ ไมโครเวฟ ไทโอยูเรีย โซเดียมซัลไฟด์

Key words : CZTS, Microwave, Thiourea, N

สารบัญ	
บทที่ 1 บทนำ	หน้า
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 โครงสร้างที่น่าจะเป็นของคอปเปอร์ ซิงค์ ทิน ซัลไฟด์ (CZTS)	4
2.2 เตาไมโครเวฟและรังสีจากเตาไมโครเวฟ	5
2.3 การสร้างคลื่นไมโครเวฟ	6
2.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	7
2.5 หลักการทำงานของเครื่อง SEM	7
2.6 การตรวจสอบชนิดและปริมาณธาตุด้วยเทคนิคการกระจายพลังงานของ	8
รังสีเอกซ์	
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
บทที่ 3 วิธีการทดลอง	
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	12
3.2 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์แคดเมียมซัลไฟด์	
3.2.1 ตอนที่ 1 การสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์	13
ที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้น	
3.2.2 ตอนที่ 2 การสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ ซิงค์ ทิน ซัลไฟด์	14
ที่มี Na2S เป็นสารตั้งต้น โดยมี Glutaraldehyde เป็นสารกำหนดขนาดอนุภาค	
3.3 การเตรียมตัวอย่างเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์	14
บทที่ 4 ผลการทดลอง	
4.1 การศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการฉายรังสีไมโครเวฟต่อค่าร้อยละของ	15
ผลิตภัณฑ์ (%yield)	
4.2 การวิเคราะห์และตรวจสอบอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์	16

# สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	
5.1 สรุปผลการทดลอง	
5.1.1 การศึกษาผลของกำลังวัตต์ที่ใช้ในการฉายรังสีไมโครเวฟต่อค่าร้อยละ	20
ของผลิตภัณฑ์ CZTS (%yeld)	
5.1.2 การวิเคราะห์และตรวจสอบอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ด้วย	20
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	
5.1.3 การวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Energy Dispersive	21
X-Ray Spectrometer (EDX)	
5.2 คำแนะนำ	21
บรรณานุกรม	22
ภาคผนวก	25

หน้า

# สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1	สีและค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ CZTS ที่กำลังไฟฟ้าต่าง ๆ	20
4.2	ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ในสภาวะต่างๆ	26

# สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	ลักษณะของธาตุเคสเตอร์ไรท์	4
2.2	โครงสร้างผลึกของเคสเตอไรท์และสแตนในท์	5
2.3	แถบเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	5
2.4	กลไกการสร้างคลื่นไมโครเวฟ	6
2.5	ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่อง SEM	8
2.6	หลักการเกิดรังสีเอกซ์	9
3.1	Flow-chart แสดงวิธีการสังเคราะห์อนุภาค Cu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4,</sub> (CZTS) ที่มี thiourea	18
	เป็นสารตั้งต้น	
3.2	Flow-chart แสดงวิธีการสังเคราะห์อนุภาค Cu $_2$ ZnSnS $_4$ (CZTS) ที่มีNa $_2$ S	17
	เป็นสารตั้งต้น โดยมี Glutaraldehyde เป็นสารกำหนดขนาดอนุภาค	
3.3	Flow-chart แสดงวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์	18
	อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	
4.1	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการ	21
	ฉายรังสิไมโครเวฟ (วัตต์) โดยใช้สารตั้งต้น 2 ตัวคือ thiourea และ Na <sub>2</sub> S	
4.2	<b>กราฟ</b> แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ ปริมาณอนุภาคของ	22
	คอปเปอร์ ซิงค์ ทินและซัลไฟด์ ที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้น	
4.3	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ ปริมาณอนุภาคของ	22
	คอปเปอร์ ซิงค์ ทินและซัลไฟด์ ที่มี Na2S เป็นสารตั้งต้นและ Glutaraldehyde	
	เป็นสารกำหนดขนาดอนุภาค	
4.4	ลักษณะอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ (CZTS) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	24
	แบบส่องกราด (SEM) (A) ที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์, (B) ที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์,	
	(C) ที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ และอนุภาคที่มี Na2S เป็นสารตั้งต้น ถูกกระตุ้นด้วยการ	
	ฉายรังสีไมโครเวฟ (D) ที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์, (E) ที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์,	
	(F) ที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ ในระยะเวลา 5 นาที	

บทที่ 1 บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

เคสเตอร์ไรท์(kesterite) มีสูตรโครงสร้างทางเคมี Cu₂ZnSn(S,Se)₄, CZTS, CZTSe หรือ Cu₂FeSn(S,Se)₄ เป็นสารประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดซับสูงถึง 10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup> และมีแถบช่องว่าง พลังงาน (Energy band gap) กว้าง 1 – 1.5 eV มีลักษณะเป็นแร่สีดำแกมเขียวหาได้ง่ายในธรรมชาติ และราคาถูก ส่วนใหญ่นำมาประยุกต์ใช้งานด้านของเทคโนโลยีแบบฟิล์มบาง จากโครงสร้างของผลึก พบว่า ธาตุซัลไฟด์ (S) พบมากในเคสเตอไรท์ ส่วนซีลีไนด์ (Se) พบมากในโครงสร้างของ สแตนไนท์ เค สเตอร์ไรท์กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ผลิตเป็นตัวดูดซับของเซลล์แสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ เนื่องจาก สารประกอบเคสเตอร์ไรท์ธรรมดาทั่วไป เช่น สังกะสี เหล็กและดีบุกหาได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าธาตุบาง ชนิดเช่น อินเดียม ซึ่งอินเดียมเป็นธาตุที่หายากและมีราคาค่อนข้างสูง

แม้ว่าประสิทธิภาพของเซลล์ที่ทำจากสารประกอบเคสเตอร์ไรท์(kesterite) จะยังต่ำกว่ำเซลล์ แสงอาทิตย์แบบดั้งเดิมที่ทำจากซิลิกอน แต่เทคโนโลยีฟิล์มบางมีต้นทุนต่ำและยังสามารถนำไป ประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางมากกว่ามีการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางโดยใช้ธาตุที่หาได้ง่าย เช่น ทองแดงสังกะสี ดีบุก และซีลีเนียม เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงาน ถึง 9.6 เปอร์เซ็นต์ ถือว่ามีการพัฒนาได้มากกว่าที่เคยมี โดยความพยายามใช้วัสดุที่มีต้นทุนต่ำสิ่งสำคัญ คือมีการจัดให้เซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่นี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพเดียวกันกับเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ที่ใช้สารอินเดียมหรือแคตเมียม ซึ่งตอนนั้นมีประสิทธิภาพระหว่าง 9-11 เปอร์เซ็นต์ และยัง ออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสามารถใช้กระบวนการผลิตที่มีต้นทุนต่ำในการผลิตฟิล์มบาง เช่น การ พิมพ์การพ่นและการจุ่มโดยกระบวนการเหล่านี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์สูญญากาศอย่างที่ใช้กับการผลิตฟิล์ม บางแบบดั้งเดิมทั่วไปที่มีต้นทุนสูงกว่ามาก โดยมีวิธีการในการสังเคราะห์ที่หลากหลายวิธีด้วยกัน อาทิเช่น Hot injection, high temperature arrested precipitation, hydrothermal และ microwave ในงานวิจัยนี้ได้ทำการ สังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ โดยการกระตุ้นให้เกิดตะกอนโดยการฉายรังสีไมโครเวฟที่ กำลังไฟฟ้า 100, 200 และ 300 วัตต์ ใช้เวลาในการฉายรังสี 5 นาที เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ สังเคราะห์ที่สภาวะต่างๆ รวมทั้งศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ ที่ มีการเปรียบเทียบการใช้สารตั้งต้น 2 ตัวดังต่อไปนี้ คือ thiourea และ Na<sub>2</sub>S (ที่มี Glutaraldehyde เป็นสารกำหนดขนาดอนุภาค) โดยการสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ด้วยการฉายรังสี ไมโครเวฟนี้ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดระยะเวลาในการสังเคราะห์ สะดวก ต่อให้การความร้อน และง่ายต่อการควบคุมตัวแปรต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการใช้เทคโนโลยี ไมโครเวฟกันอย่างแพร่หลาย

ในการตรวจสอบอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์จะทำการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด Scanning Electron Microscope (SEM) เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐาน วิทยาของวัสดุในระดับจุลภาคและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง โดยลำแสงของ อิเล็กตรอนจะส่องกราดไปบนผิวของวัตถุ ทำให้ภาพที่ได้มีลักษณะเป็น 3 มิติ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ Energy DispersiveX-Ray Spectrometer (EDX) สำหรับการวิเคราะห์ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ใน ตัวอย่าง ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมและการสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ในระบบปิด ด้วย การฉายรังสีไมโครเวฟโดยมีการเปรียบเทียบการใช้สารตั้งต้น 2 ตัวดังต่อไปนี้ คือ thiourea และ Na<sub>2</sub>S โดยมี Glutaraldehyde เป็นสารกำหนดขนาดอนุภาค

2. เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์

 เพื่อศึกษาผลกระทบของกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ต่อ ค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์

#### 1.3 ขอบเขตการศึกษา

 สังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ในระบบปิด ด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟโดยมีการ เปรียบเทียบการใช้สารตั้งต้น 2 ตัวดังต่อไปนี้ คือ thiourea และ Na<sub>2</sub>S โดยมี Glutaraldehyde เป็น สารกำหนดขนาดอนุภาค

 วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาของอนุภาคและองค์ประกอบธาตุเชิงปริมาณด้วยเทคนิค กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM) ที่ต่อกับเครื่องมือ วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy dispersive x-ray spectrometer; EDX)

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อศึกษาผลของกำลังไฟฟ้าที่มีต่อค่าร้อยละผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ ทินซัลไฟด์

 เพื่อนำสารที่สังเคราะห์ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นสารกึ่งตัวนำของเซลล์แสงอาทิตย์หรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าชนิดต่างๆ

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิคและการประยุกต์ใช้เครื่องไมโครเวฟในการสังเคราะห์สารได้

 4. ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุใน ระดับจุลภาคได้แก่เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy dispersive x-ray spectrometer; EDX) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM)

 ศึกษาอัตราส่วนของโลหะต่อซัลเฟอร์ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาคุณสมบัติ ทางไฟฟ้าต่อไป

6. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์สารกึ่งตัวนำให้มีอัตราส่วนโมลของ Cu:Zn:Sn:S เป็นไปตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ต้องการ

# บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 โครงสร้างที่น่าจะเป็นของคอปเปอร์ ซิงค์ ทิน ซัลไฟด์ (CZTS)

เคสเตอร์ไรท์(kesterite) จัดอยู่ในกลุ่มสแตนไนท์ (stannite) มีสูตรโครงสร้างทางเคมี Cu<sub>2</sub>ZnSn(S,Se)<sub>4</sub> หรือ CZTS,CZTSe หรือ Cu<sub>2</sub>FeSn(S,Se)<sub>4</sub> เป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นจากพื้นดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์ปลอดสารพิษเป็นสารประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดซับสูงถึง 10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup> และ มีแถบช่องว่างพลังงาน(Energy band gap) กว้าง 1–1.5 eV มีลักษณะเป็นแร่สีดำแกมเขียว ดัง รูปที่ 2.1 หาได้ง่ายในธรรมชาติและราคาถูก รู้จักกันครั้งแรกในปีค.ศ. 1958 ในรัสเซียพบในเหมืองแร่ หลายแห่งทั้งในรัสเซียอเมริกายุโรปจีนส่วนใหญ่นำมาประยุกต์ใช้งานด้านของเทคโนโลยีแบบฟิล์มบาง จากโครงสร้างของผลึกพบว่าเป็นระบบผลึกแบบ Tetragonal คือระบบผลึกแบบนี้มีด้านยาวเท่ากัน 2 ด้าน ส่วนด้านที่ 3 มีความยาวต่างออกไปและทั้ง 3 ด้านทำมุม 90 องศาซึ่งกันและกันและในโครงสร้าง ของผลึกยังพบว่าธาตุซัลไฟด์(S) พบมากในเคสเตอไรท์ ส่วนซีลีไนด์(Se) พบมากในโครงสร้างของ สแตนไนท์ ดังรูปที่ 2.2 เคสเตอร์ไรท์กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ผลิตเป็นตัวดูดซับของเซลล์แสงอาทิตย์ ต้นทุนต่ำ เนื่องจากสารประกอบเคสเตอร์ไรท์ธรรมดาทั่วไป เช่น สังกะสี เหล็กและดีบุกหาได้ง่ายและมี ราคาถูกกว่าธาตุบางชนิดเช่นอินเดียมซึ่งอินเดียมเป็นธาตุที่หายากและมีราคาค่อนข้างสูง



รูปที่ 2.1 ลักษณะของธาตุเคสเตอร์ไรท์ (วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลล์, 2555)



**รูปที่ 2.2** โครงสร้างผลึกของเคสเตอไรท์ **(**ซ้าย**)**และสแตนไนท์ **(**ขวา**)**ลูกกลมใหญ่สีเหลืองคือซัลไฟด์(S) กลมสีเหลืองเล็กคือซีลีไนด์(Se) สีน้ำเงินคือทองแดง(Cu) สีเหลืองคือสังกะสี(Zn) สีแดงคือ ดีบุก(Sn) (วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลล์, 2555)

## 2.2 เตาไมโครเวฟและรังสีจากเตาไมโครเวฟ

เตาไมโครเวฟใช้คลื่นรังสีไมโครเวฟในการทำอาหาร ซึ่งเป็นคลื่นแบบเดียวกันทั้งเตาที่ใช้ตาม บ้าน ร้านค้า หรือโรงงานต่างๆ ปัจจุบันยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนในการใช้เตาไมโครเวฟจากผู้ผลิต การ ดูแลรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ดี หรือป้องกันอันตรายจากรังสี เราจึงควรรู้คุณสมบัติบางอย่างและข้อควร ระวังในการใช้เตาไมโครเวฟ



ร**ูปที่ 2.3** แถบเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (บทความสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, 2558)

ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นเดียวกับแสงสว่าง โดยอยู่ในช่วงของคลื่นวิทยุความถี่สูง (High frequency radio wave) เมื่อรังสีมีความถี่สูงขึ้น ความยาวคลื่นจะลดลง คลื่นที่มีความถี่สูงมาก ความยาวคลื่นจึงสั้นมาก ดังนั้น คลื่นชนิดนี้จึงได้ชื่อว่าไมโครเวฟ ซึ่งแปลว่าคลื่นสั้นมาก รังสีอินฟราเรด (Infrared) แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) และรังสีเอกซ์ (X-ray) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกัน แต่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าไมโครเวฟ

คลื่นไมโครเวฟที่ผ่านเข้าไปในสารตัวอย่างหรือของเหลวตัวอย่างจะทำให้โมเลกุลของน้ำเกิดการ สั่นตามความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ ทำให้เกิดการสั่นหรือเสียดสีกันของโมเลกุล จึงเกิดความร้อนและทำ ให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ความร้อนจะเพิ่มขึ้นเร็วหรือช้าจะขึ้นกับปริมาณความชื้น รูปร่าง ปริมาตร และมวลของสารที่ใส่เข้าไป ปกติพลังงานของคลื่นไมโครเวฟจะถูกดูดกลืนโดยน้ำในสารละลายแล้ว เปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนหมด (กรรณิกา แท่นคำ, 2558)

# มีเล็กตรอน ท่อน่าคลื่น คลื่นความกี่สูง ขั้วลบ ขั้วแม่เหลีก ช่องว่าง ขั้วบวก

# 2.3 การสร้างคลื่นไมโครเวฟ

รูปที่ 2.4 กลไกการสร้างคลื่นไมโครเวฟ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2558)

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ขั้วลบของแมกนิตรอน ก็จะปล่อยอนุภาคไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอน ออกมา อิเล็กตรอนจะวิ่งเข้าหาทรงกระบอกกลวงซึ่งภายในเซาะเป็นร่องยาวไว้ ทรงกระบอกนี้ล้อมอยู่ รอบขั้วลบ และทำหน้าที่เป็นขั้วบวก ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็ก ประกอบกับลักษณะ ช่องว่างเป็นร่องยาวจะส่งผลให้เกิดแรงผลักดันอิเล็กตรอนให้วิ่งเป็นวงกลมรอบขั้วลบ เกิดสภาพ เหมือนกับมีกระแสไฟฟ้าไหลกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลที่ได้ก็คือจะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เส้น ที่มีลักษณะเป็นคลื่น) ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเท่ากันจากนั้นก้านส่งคลื่นก็จะส่งคลื่นเข้า สู่ท่อนำคลื่นต่อไป

## 2.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scaning Electron Microscope : SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ Electron เป็นแหล่งกำเนิด แสง เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาลักษณะสัณฐานของวัสดุในระดับจุลภาค ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เล็กมาก และ เนื่องจากข้อจำกัดของกล้องจุลทรรศน์แบบแสงที่มีความยาวคลื่นแสงขนาดใหญ่กว่าลักษณะสัณฐานบาง ชนิดที่ต้องการศึกษา และกำลังความสามารถในการแยกชัดของกล้องจุลทรรศน์แบบแสงธรรมดามีค่าต่ำ ใช้ดูวัตถุเล็กสุดประมาณ 0.2 ไมโครเมตร และให้กำลังขยายสูงสุดไม่เกิน 3000 เท่า ซึ่งไม่สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดของวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูง มีความสามารถในการแยกชัดดี เนื่องจากมีความยาวคลื่นสั้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานของวัสดุ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมี กำลังขยายมากกว่า 3000 เท่า จนถึงระดับมากกว่า100 ,000 เท่า และสามารถแจกแจงรายละเอียดของ ภาพ ซึ่งขึ้นกับลักษณะตัวอย่างได้ตั้งแต่ 3 ถึง 100 นาโนเมตร อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับเทคนิค การวิเคราะห์อื่น เช่น Energy Dispersive Spectrometry (EDS) และ Wavelength Dispersive Spectrometry (WDS) ที่เป็นข้อมูลทางเคมี จึงทำให้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นที่ นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน (สริญญา ชวพันธ์, 2012)

## 2.5 หลักการทำงานของเครื่อง SEM

หลักการทำงานของเครื่อง SEM จะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนซึ่งทำหน้าที่ผลิต อิเล็กตรอนเพื่อป้อนให้กับระบบ โดยกลุ่มอิเล็กตรอนที่ได้จากแหล่งกำเนิดจะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า จากนั้นกลุ่มอิเล็กตรอนจะผ่านเลนส์รวบรวมรังสี (Condenser lens) เพื่อทำให้กลุ่มอิเล็กตรอน กลายเป็นลำอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถปรับให้ขนาดของลำอิเล็กตรอนใหญ่หรือเล็กได้ตามต้องการ



**รูปที่ 2.5** ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่อง SEM (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการ เรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) ข้อดีของเครื่อง SEM เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง Transmission Electron Microscope (TEM) คือ ภาพโครงสร้างที่เห็นจากเครื่อง SEM จะเป็นภาพลักษณะ 3 มิติ ในขณะที่ภาพจากเครื่อง TEM จะให้ภาพลักษณะ 2 มิติ อีกทั้งวิธีการใช้งานเครื่อง SEM จะมีความรวดเร็วและใช้งานง่ายกว่า เครื่อง TEM มาก

## 2.6 การตรวจสอบชนิดและปริมาณธาตุด้วยเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (Energy dispersive X-ray Spectroscopy; EDX)

มีหลักการจากการกระเจิงของอิเล็กตรอนในชิ้นงานแล้วปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมาซึ่งรังสีเอกซ์ ที่ปล่อยออกมานั้นเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละธาตุที่ปล่อยออกมา ซึ่งในอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียส ที่มีประจุบวก และอิเล็กตรอนที่มีประจุลบอยู่รอบๆ ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างประจุภายในอะตอม แต่ประจุทั้งสองจะต้องสมดุลกันในแต่ละธาตุการเรียงตัวของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสของอะตอมนั้น เป็นที่เข้าใจกันมาเป็นเวลานานแล้วว่าจะเป็นลักษณะของวงอิเล็กตรอน (Electron shells) โดย อิเล็กตรอนชั้นในสุดจะมีพลังงานต่ำสุด แต่มีพลังงานพันธะที่แข็งแรงที่สุด และอิเล็กตรอนชั้นนอกนั้นจะ มีพลังงานศักย์สูงแต่พลังงานพันธะต่ำ และระดับชั้นพลังงานชั้นต่างๆ ของอิเล็กตรอนจะเรียงจากวงใน ออกไปนอกได้ ดังนี้ K, L, M, N, O, P และ Q ตามลำดับ และเนื่องจากความแตกต่างของระดับพลังงาน ยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนรอบๆนิวเคลียส ทำให้อิเล็กตรอนตั้งต้น (Primary electron) ที่มีพลังงานศักย์ มากกว่าจึงมักจะไปแทนที่ในระดับพลังงานชั้น K มากกวาชั้น L (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558)



รูป 2.6 หลักการเกิดรังสีเอกซ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558)

การชนของอิเล็กตรอนตั้งต้นจะเข้าไปชนอิเล็กตรอนภายในวงให้หลุดออกไปจากอะตอมจึงเกิด สภาวะที่ถูกกระตุ้นคือ ไม่เสถียร จึงมีความพยายามทำให้เกิดการเสถียร โดยการที่อิเล็กตรอนใน ระดับชั้นพลังงานวงนอกจะเข้าไปแทนที่ โดยกระโดดลงไปแทนที่ช่องว่างที่อิเล็กตรอนวงในหลุดออก ไป แล้วทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ (X-ray photon) ซึ่งมี พลังงานเท่ากับความแตกต่างของอิเล็กตรอนจากระดับชั้นพลังงานที่เข้ามาแทนที่กันดังรูป 2.7 และ ตัวรับสัญญาณจะรับรังสีเอกซ์ที่ถูกปลดปล่อยออกมานับจำนวนและพลังงานที่ปล่อยออกมาแล้วนำเสนอ ในรูปของกราฟระหว่างระดับพลังงานและจำนวนที่ปลดปล่อยออกมาซึ่ง อิเล็กตรอนในแต่ละชั้นของธาตุ ต่างๆ ก็จะมีพลังงานแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวดังนั้น เราสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้ว่ามี องค์ประกอบของธาตุอะไรบ้าง และมีปริมาณเป็นสัดส่วนเท่าใด

## 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Ingrid et al (2011) เซลล์แสงอาทิตย์ชาลโคไพไรต์ (Chalcopyrite) หรือ CuInSe<sub>2</sub> เป็นโลหะ ผสมที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากธาตุอินเดียมเป็นธาตุที่หายากจึงเกิดปัญหาการขาดแคลน จึงมี การนำเสนอเคสเตอร์ไรท์ (kesterite) ที่มีสูตรโครงสร้างคือ Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> มาใช้งานแทนซึ่งเคสเตอร์ไรท์ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตามทฤษฎีแล้วเคสเตอร์ไรท์ (kesterites)และชาลโคไพไรต์ (chalcopyrites) มีความเหมือนและแตกต่างกันโดยการตรวจสอบด้วยวิธีการหลากหลายวิธีเช่น การ Xray diffraction, การสแกนกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน และ luminescence

Venkata et al (2015) ศึกษาอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ (Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>, CZTS) ที่เป็นสาร กึ่งตัวนำประเภทพีที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสารที่นำมาประยุกต์ใช้งานในด้านของเซลล์แสงอาทิตย์ แบบฟิล์มบาง ในปัจจุบันมีประยุกต์วิธีการสังเคราะห์ที่รวดเร็วและเชื่อถือโดยการฉายด้วยรังสีไมโครเวฟ ไปยังสารละลายเพื่อให้ได้อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟล์ (CZTS) การสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ ทินซัลไฟล์(CZTS) ได้รับการยืนยันโดยการฉายรังสีและการตรวจวัดด้วยเครื่องราเมน สเปกโตสโครปี คุณสมบัติของแสง เช่น แถบช่องว่างพลังงานที่ได้มากจากการพลอตของ Tauc สามารถตรวจสอบด้วย เทคนิคยูวี-วิสิเบิล แอพซอพชั่น สเปกโตโฟโตเมทรีได้ค่าเท่ากับ 1.27 eV ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับ การดูดซับแสงอาทิตย์ จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคด้วยกล องจุลทรรศน อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope; TEM )และกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(Scanning Electron Microscope : SEM) พบว่าได้โครงสร้าง 3 มิติระดับนา โนมีที่เป็นลักษณะเหมือนดอกไม้จากผลึก CZTS

Delbos (2012) นำเคสเตอร์ไรท์ หรือ Cu<sub>2</sub>ZnSn(S,Se)<sub>4</sub>, CZTS ซึ่งเป็นสารที่สามารถเตรียมได้ ง่ายและราคาถูกมาทดลองใช้เป็นสารกึ่งตัวนำในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง พบว่าเคสเตอร์ไรท์มี ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในด้านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่ได้รับ ความสนใจจากกลุ่มนักวิทยาศาตร์เป็นอย่างมาก และได้มีการนำไปปรับปรุงและใช้งานในกระบวนการ เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Copper Indium Gallium Sulfide/Selenide, CIGS นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ ได้มีการแสดงความคิดเห็นรวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ ทินซัลไฟด์ Cu<sub>2</sub>ZnSn(S,Se)<sub>4</sub> (CZTS) ด้วย

Wei et al (2013) สังเคราะห์ CuInS<sub>2</sub>/ZnS ด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟ ซึ่งเป็นสารที่ละลายน้ำ ได้และคุณภาพสูงควบคุมขนาดอนุภาคโดยกลูต้าไธโอล(GSH) ซึ่งมีขนาดของอนุภาคประมาณ 3.3 นา โนเมตร และสีที่มองเห็นจะอยู่ในช่วง ยูวี วิชซิเบิล-อินฟาเรด ความเป็นพิษต่ำ มีคุณสมบัติการเรืองแสง ถูกนำมาใช้เป็นป้ายสัญญาณ fluoroimmunoassay biomarker ของ IL-6 และนำมาวินิจฉัยโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆได้

Cao et al (2013) การพัฒนาเพื่อสังเคราะห์ฟิลม์บาง Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>(CZTS) แบบขั้นตอนเดียว ศึกษาผลกระทบของพีเอชและสารตั้งต้น ZnCl<sub>2</sub> ต่อการก่อตัวของ CZTS พบว่าที่พีเอช 3.5 – 4 และ ปริมาณซิงค์คลอไรด์ 1.75 มิลลิโมล จะได้ฟิลม์บางที่มีคุณภาพสูง มีโครงสร้างผลึกเคสเตอร์ไรท์ (kesterite) มีช่องว่างแถบพลังงานประมาน 1.48 อิเล็คตรอนโวล มีประสิทธิภาพ 0.3 เปอร์เซ็น

Hao et al (2010) Cu2ZnSnSe4, (CZTSe) เป็นหนึ่งในวัสดุที่นำมาใช้งานในชั้นดูดกลืนของ เซลล์แสงอาทิตย์ มีองค์ประกอบหลักคือ ซิงค์และดีบุก ซึ่งมีความพิษน้อยมาก และมีค่าแถบช่องว่าง พลังงานอยู่ที่ประมาณ 1.5 eV และมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนของสแงที่สูงประมาณ 10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup> ดังนั้น อนุภาคผลึกของ CZTSe ในตัวทำละลายคือ oleylamine (OLA) สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้จากวิธีการ hot-injection การศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยา อัตราส่วนโมล รูปร่างของอนุภาคและสเปกตรัมการ ดูดกลืน ด้วยเทคนิค X-ray diffraction (XRD), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), transmission electron microscopy (TEM) และ UV–vis absorption spectra จากผล การศึกษาพบว่า monodispersed ของ nanocrystals เป็น polycrystalline ที่มีเฟสเดียวอยู่ในช่วง 15-20 nm. การวัดแสงที่แสดงให้เห็นอยู่ในช่องว่างตรงวงมีค่าเท่ากับ 1.52 eV ซึ่งเหมาะสมที่สุด สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ

Chao et al (2011) การสังเคราะห์ด้วยวิธี high เป็นการสังเคราะห์ด้วยวิธีที่ง่าย ราคาถูก ที่ อุณหภูมิต่ำกว่า 220 องศาเซลเซียส โดยใช้ Oleylamine และ Oleic acide เป็นตัวกระตุ้นและควบคุม อนุภาคอนุภาคตามลำดับ และได้โครงสร้างเป็นผลึกขนาดเล็กระดับนาโน ซึ่งได้ปริมาณผลิตภัณฑ์และ คุณภาพที่สูง

Shri et al (2013) การศึกษาสังเคราะห์ผงผลึกนาโนของ Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> (CZTS) โดยกระบวนการ hydrothermal โดยใช้ thiourea และ sulfur(S) เป็นสารตั้งต้น จากนั้นนำผงผลึกนาโนของ CZTS ไป วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพโดยใช้รังสีเอกซ์เพื่อดูขนาดและพื้นที่ของอนุภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope; TEM) แสดงจุดราเมนอยู่ที่ช่วง 337.5 – 1 cm. โดยเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของอนุภาค CZTS ที่สังเคราะห์ได้ การสังเคราะห์เค สเตอร์ไรท์(kesterite) โดยกระบวนการ hydrothermal ทำให้ได้อนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 5 นาโนเมตร อีกทั้งการสังเคราะห์โดยกระบวนการ hydrothermal เป็นกระบวนการสังเคราะห์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังให้ค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 90% จากนั้นมีการตรวจวัดด้วยเทคนิค ยูวี-วิสิเบิล แอพซอพชั่น สเปกโตโฟโตเมทรี ทำให้เห็นช่วง band gap ของการสังเคราะห์อนุภาค CZTS เป็น 1.7 eV ซึ่งมีค่าที่เหมาะสมสำหรับแผงวงจรเซลล์แสงอาทิตย์

Brendan et al (2012) อนุภาคนาโน Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> (CZTS) ถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในปี 2012 ด้วยเทคนิคขึ้นตอนเดียวโดยใช้การฉายรังสีไมโครเวฟ ใช้อุณหภูมิ 1190 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที โดยใช้เกลือคลอไรด์ในเอทานอล ไกลคอล เพื่อป้องกันการเกิดอนุภาคที่มีคอเปอร์มากกว่าซิงค์ หรือ คอปเปอร์มาก ซิงค์น้อย ขนาดของอนุภาคมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 7.6 ± 2.1 nm และมี การจับกลุ่มกลายเป็นก้อนอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้อนุภาคที่ สังเคราะห์ได้นี้เท่ากับ 0.25%

## บทที่ 3

## วิธีการทดลอง

## 3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

#### 3.1.1เครื่องมือและอุปกรณ์

1. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope :SEM);รุ่น LEO 1450 VP ต่อเชื่อมกับเครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)

2. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettle Toledo รุ่น ML 204

3. เตาไมโครเวฟ(Microwave); ยี่ห้อSAMSUNG รุ่นME711K

4. เตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle furnace); รุ่น CWF11/13/301

5. เครื่องกรองสูญญากาศ (Vacuum pump)

6. เครื่องกวนสาร (Stirrer Hot plate); รุ่น C – MAG HS10

7. หลอดเซนติฟิวพลาสติกฝาเกลียว (Nalgene centrifuge ware)

8. กระดาษกรอง Nylon Membrane Filters 0.45  $\mu\text{m}$ 

9. แท่งแม่เหล็กกวนสาร (magnetic bar)

#### 3.1.2 สารเคมี

 คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ ไดไฮเดรต (Copper (II) Chloride Dihydrate); สูตรทางเคมี CuCl<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O น้ำหนักโมเลกุล 170.48กรัมต่อโมล เกรด analytical reagent grade บริษัท QREC CHEMICAL CO.,LTD

2. ซิงค์ (II) คลอไรด์ (Zinc (II) Chloride); สูตรทางเคมี ZnCl<sub>2</sub>น้ำหนักโมเลกุล 136.28 กรัมต่อ โมล เกรด analytical reagent grade บริษัท LOBA CHEMIE PVT.LTD ประเทศอินเดีย

3.ทิน (II) คลอไรด์ (Tin (II) Chloride); สูตรทางเคมี SnCl<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O น้ำหนักโมเลกุล 225.63กรัม ต่อโมล เกรด analytical reagent grade บริษัทAJAX FINECHEM PVT.LTD

4. ไทโอยูเรีย (Thiourea); สูตรทางเคมี CS(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>น้ำหนักโมเลกุล 76.12 กรัมต่อโมล เกรด analytical reagent grade บริษัท LOBA CHEMIE PVT.LTD ประเทศอินเดีย

5. โซเดียมซัลไฟล์ (Sodium Sulphide); สูตรทางเคมี Na<sub>2</sub>S น้ำหนักโมเลกุล 78.04 กรัมต่อ โมล เกรด analytical reagent grade บริษัท LOBA CHEMIE PVT.LTD ประเทศอินเดีย

6. กลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde); สูตรทางเคมี C₅H<sub>8</sub>O₂น้ำหนักโมเลกุล 100.12 กรัมต่อ โมล เกรด analytical reagent grade บริษัท LOBA CHEMIE PVT.LTD ประเทศอินเดีย 7. แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ (Ammonium Hydroxide); สูตรทางเคมี NH4OH น้ำหนัก โมเลกุล 35.05 กรัมต่อโมล เกรด laboratory reagent

8. เอทานอล (99% Ethanol); สูตรทางเคมี CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OHน้ำหนักโมเลกุล 46.07กรัมต่อโมล บริษัท SIGMA-ALODRICH.ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### 3.2 วิธีการทดลอง

## 3.2.1 ตอนที่ 1 การสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ (Copper Zinc Tin Sulfide) ที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้น

1. ชั่ง CuCl<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O 0.298 กรัม, ZnCl<sub>2</sub> 0.151 กรัม, SnCl<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O 0.209 กรัม และ thiourea 0.34 กรัม ลงใน Beaker จากนั้นละลายด้วยน้ำกลั่น 30 มิลลิลิตร และ NH<sub>4</sub>OH 10 มิลลิลิตร

2. นำไปตั้งบนเครื่องกวนสาร พร้อมกับใส่ magnetic bar จากนั้นกวนเป็นเวลา 30 นาที

3. ใช้ Syringe ดูดสารละลายผสมมาแบ่งใส่ใน Nalgene centrifuge ware ขวดละ 5 มิลลิลิตร

4.นำไปให้ความร้อนโดยการฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังวัตต์ 100, 200 และ 300 วัตต์ ใช้เวลา
5 นาที จากนั้นทิ้งสารละลายไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง

6. ทำการกลั่นและล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่น 1 ครั้ง และ Ethanol 2 ครั้ง

นำตะกอนที่ได้มาระเหยตัวทำละลายออกด้วยการอบที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง และเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะได้ตะกอนของอนุภาค
Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> (CZTS) ที่เป็นผงละเอียด สีดำแกมเขียวเป็นผลิตภัณฑ์

## 3.2.2 ตอนที่ 2 การสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ ซิงค์ ทิน ซัลไฟด์ (Copper Zinc Tin Sulfide) ที่ มีNa<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้น โดยมี Glutaraldehyde เป็นสารกำหนดขนาดอนุภาค

1. ชั่ง CuCl<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O 0.298 กรัม, ZnCl<sub>2</sub> 0.151 กรัม, SnCl<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O 0.209 กรัม และ Na<sub>2</sub>S 0.3512 กรัม ลงใน Beaker จากนั้นใส่ Glutaraldehyde 1.7 มิลลิลิตร

2. นำมาละลายด้วยน้ำกลั่น 30 มิลลิลิตร และ NH<sub>4</sub>OH 10 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปตั้งบนเครื่อง กวนสาร พร้อมกับใส่ magnetic bar จากนั้นกวนเป็นเวลา 30 นาที

3. ใช้ Syringe ดูดสารละลายผสมมาแบ่งใส่ใน Nalgene centrifuge ware ขวดละ 5 มิลลิลิตร

4. นำไปให้ความร้อนโดยการฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังวัตต์ 100, 200 และ 300 วัตต์ ใช้เวลา
5 นาทีจากนั้นทิ้งสารละลายไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง

6. ทำการกลั่นและล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่น 1 ครั้ง และ Ethanol 2 ครั้ง

นำตะกอนที่ได้มาระเหยตัวทำละลายออกด้วยการอบที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง และเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะได้ตะกอนของอนุภาค
Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>, (CZTS) ที่เป็นผงละเอียด สีดำแกมเขียวเป็นผลิตภัณฑ์

## 3.3 การเตรียมตัวอย่างเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์

## 3.3.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scaning Electron Microscope : SEM)

1. นำพู่กันแตะผงตะกอนของ Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4,</sub> (CZTS) ไปติดบน Stub ที่มีแผ่นคาร์บอนเทปอยู่ และใช้ลูกยางเป่าแรงๆ เพื่อไล่ผงตะกอนที่ไม่ติดบนแผ่นคาร์บอนเทปกาวออก

2. เคลือบทองด้วยเครื่อง Iron sputter coater เพื่อให้ภาพถ่ายที่ได้มีความคมชัดและเหมาะ สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDX)

3. วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

## บทที่ 4

#### ผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ (Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>, CZTS) ในระบบปิดโดย การฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 100, 200 และ 300 วัตต์ ในระยะเวลา 5 นาที โดยการศึกษาจะ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาผลของกำลังวัตต์ที่ใช้ในการฉายรังสีไมโครเวฟต่อค่าร้อย ละของผลิตภัณฑ์ CZTS (%yield) ตอนที่ 2 ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ ทินซัลไฟด์ (CZTS) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microsco; SEM)และวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDX)

# 4.1 การศึกษาผลของกำลังวัตต์ที่ใช้ในการฉายรังสีไมโครเวฟต่อค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ CZTS (%yeld)

การศึกษาผลของกำลังวัตต์ที่ใช้ในการฉายรังสีไมโครเวฟต่อค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ CZTS (%yield) ในระบบปิดโดยการฉายรังสีไมโครเวฟ โดยใช้ CuCl ZnClและ SnCl เป็นสารตั้งต้นและมีการ เปรียบเทียบการใช้สารตั้งต้น 2 ตัว ดังต่อไปนี้ คือ thiourea และ Na<sub>2</sub>S โดยมี Glutaraldehyde เป็น สารควบคุมขนาดอนุภาค จากนั้นทำการฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 100, 200 และ 300 วัตต์ ในระยะเวลา 5 นาที สังเกตว่าเมื่อกำลังไฟฟ้าน้อยๆ ตะกอนจะมีลักษณะเป็นสีดำแกมเขียวอ่อน เมื่อเพิ่ม กำลังไฟฟ้าให้มากขึ้นสีจะเข้มขึ้นเป็นสีดำแกมเขียวเข้ม ซึ่งได้ค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ ดังตารางที่ 4.1

## 4.2 การวิเคราะห์และตรวจสอบอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์

#### 4.2.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM)



ร**ูปที่ 4.4** ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(SEM) ของอนุภาคที่มี Thiourea เป็นสาร ตั้งต้น ถูกกระตุ้นด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟ (A) ที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ (B) ที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ (C) ที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ และอนุภาคที่มี Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้น ถูกกระตุ้นด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟ (D) ที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ (E) ที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ (F) ที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ ในระยะเวลา 5 นาที

จากการวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) ของอนุภาคที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้น ถูกกระตุ้นด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟ ในระยะเวลา 5 นาที รูปที่ 4.3 (A) ที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ พบว่าอนุภาคที่ได้มีลักษณะเป็นโครงผลึกแบบแผ่น ขี ้ขนาดใหญ่ ผิวมีลักษณะเป็นเกร็ดที่ซ้อนทับกัน ขนาดของเกร็ดมีหลากหลายขนาดซ้อนทับกันอยู่และ มี รอยแตกเล็กน้อย รูปที่ 4.3 (B) ที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ พบว่าเมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอนุภาคที่สังเคราะห์ ได้มีขนาดเล็กลง ผิวเรียบขึ้น ส่งผลให้การผสานกันของผิวผลึกดีขึ้นและรอยแตกชัดขึ้น ซึ่งจะเห็น ความแตกต่างได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าเป็น 300 วัตต์ ดังรูปที่ 4.3 (C) เกร็ดมีขนาดเล็กลง ้ผิวของอนุภาคผสานกันได้ดีมากยิ่งขึ้นลักษณะรอยแตกชัดขึ้น ส่วนอนุภาคที่มี Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้น ถูก กระตุ้นด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟ ในระยะเวลา 5 นาที พบว่ามีลักษณะแตกต่างจากอนุภาคที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้นอย่างชัดเจน โดยพบว่าที่รูปที่ 4.3 (D) ที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ผิวของอนภาค เรียบ มีรอยแตก รูปที่ 4.3 (E) ที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ พบว่ารอยแตกเริ่มน้อยลง ความขรุขระเพิ่มขึ้น เป็นปุ่มความขรุขระที่ค่อนข้างละเอียด มีความเป็นรูพรุนขนาดเล็กและเมื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าเป็น 300 วัตต์ ้ดังรูปที่ 4.3 (F) พบว่าเกร็ดมีขนาดใหญ่ขึ้น ความขรุระมากขึ้น และเป็นรูพรุนขนาดใหญ่

สารตั้งต้น	เวลาในการฉาย รังสีไมโครเวฟ	กำลังไฟฟ้า (วัตต์ )	ร้อยละโดยน้ำหนักของ ผลิตภัณฑ์ (At%)				อัตราส่วน (mol)				
	(นาท)		Cu	Zn	Sn	S	Cu	Zn	Sn	S	
							(2)	(1)	(1)	(4)	
		100	36.15	13.16	17.34	33.34	2	0.73	0.96	1.84	
Thiourea	5	200	37.75	11.76	22.53	27.97	2	0.62	1.20	1.48	
		300	21.91	11.32	14.88	51.89	2	1.03	1.36	4.74	
		100	18.57	21.08	17.22	33.13	2	2.27	1.85	3.56	
Na <sub>2</sub> S	5	200	24.85	18.22	13.85	43.08	2	1.47	1.11	3.47	
		300	23.13	18.20	17.46	41.21	2	1.57	1.51	3.56	

4.2.2 การวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDX)

ตารางที่ 4.2 แสดงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ในสภาวะต่างๆ

จากตารางที่ 4.2 เป็นการวิเคราะห์หาองค์ประกอบและปริมาณของธาตุบนอนุภาคด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDX) พบวาอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ มีการเพิ่มขึ้น และลดลงขององค์ประกอบร้อยละโดยอะตอม(At%) ที่ต่างกันดังตาราง ซึ่งค่าดังกล่าวสามารถนำมา คำนวณหาอัตราส่วนโมลได้ ซึ่งวิธีการคำนวณอัตราส่วนโมลดังแสดงภาคผนวก เมื่อทำการฉายรังสี ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ระยะเวลา 5 นาที ไปยังอนุภาคที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้น พบว่าจะ มีปริมาณขององค์ประกอบร้อยละโดยอะตอม(At%)คอปเปอร์, ซิงค์, ทินและซัลเฟอร์เท่ากับ 36.15, 13.16, 17.34 และ 33.34 ตามลำดับ และได้อัตราส่วนโมลของการแทนที่คอปเปอร์ด้วยซิงค์และทินเมื่อ เทียบกับซัลเฟอร์เท่ากับ 2 : 0.7 : 0.9 : 1.8 (Cu:Zn:Sn:S) เมื่อทำการฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ ระยะเวลา 5 นาทีไปยังอนุภาคที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้นจะมีปริมาณขององค์ประกอบ ร้อยละโดยอะตอมของคอปเปอร์, ซิงค์, ทินและซัลเฟอร์เท่ากับ 37.75, 11.76, 22.53 และ 27.97 ตามลำดับ อัตราส่วนโมลของการแทนที่คอปเปอร์ด้วยซิงค์และทินเมื่อเทียบกับซัลเฟอร์เท่ากับ 2 : 0.6 : 1.2 : 1.4 (Cu:Zn:Sn:S) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณน้อยและเมื่อเพิ่มกำลังวัตต์ในการฉาย รังสีมากขึ้น ธาตุจะเกิดการแทนที่และรวมตัวกันเป็นตะกอนได้ดีและทำปฏิกิริยากันสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่ง การฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ ระยะเวลา 5 นาที ไปยังอนุภาคที่มี thioureaเป็นสารตั้ง ต้น จะมีปริมาณขององค์ประกอบร้อยละโดยอะตอมของคอปเปอร์, ซิงค์, ทินและซัลเฟอร์เท่ากับ 21.91, 11.32, 14.88 และ 51.89 ตามลำดับ อัตราส่วนโมลของการแทนที่คอปเปอร์ด้วยซิงค์และทินเมื่อเทียบ กับซัลเฟอร์เท่ากับ 2:1:1.3:4 (Cu:Zn:Sn:S) และมีค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์สูงที่สุด

แต่เมื่อทำการฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ระยะเวลา 5 นาที ไปยังอนุภาคที่มี Na2Sเป็นสารตั้งต้น พบว่าจะมีปริมาณขององค์ประกอบร้อยละโดยอะตอม(At%)ของคอปเปอร์, ซิงค์, ทินและซัลเฟอร์เท่ากับ 18.57, 21.08, 17.22 และ 33.13 ตามลำดับ และได้อัตราส่วนโมลของการ แทนที่คอปเปอร์ด้วยซิงค์และทินเมื่อเทียบกับซัลเฟอร์เท่ากับ 2 : 2.2 : 1.8 : 4.7 (Cu:Zn:Sn:S) เมื่อทำ การฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ ระยะเวลา 5 นาที ไปยังอนุภาคที่มี Na<sub>2</sub>Sเป็นสารตั้งต้น จะมีปริมาณขององค์ประกอบร้อยละโดยอะตอมของคอปเปอร์, ซิงค์, ทินและซัลเฟอร์เท่ากับ 24.85, 18.22, 13.85 และ 43.08 ตามลำดับ อัตราส่วนโมลของการแทนที่คอปเปอร์ด้วยซิงค์และทินเมื่อเทียบ ้กับซัลเฟอร์เท่ากับ 2 : 1.4 : 1.1 : 3.4 (Cu:Zn:Sn:S) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณน้อย และเมื่อเพิ่ม กำลังวัตต์ในการฉายรังสีมากขึ้น ธาตุจะเกิดการแทนที่และรวมตัวกันเป็นตะกอนได้ดีและทำปฏิกิริยากัน ้สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งการฉายรังสีไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ ระยะเวลา 5 นาที ไปยังอนุภาคที่มี Na2Sเป็นสารตั้งต้น จะมีปริมาณขององค์ประกอบร้อยละโดยอะตอมของคอปเปอร์, ซิงค์, ทิน และซัลเฟอร์เท่ากับ 23.13, 18.20, 17.46 และ 41.21 ตามลำดับ อัตราส่วนโมลของการแทนที่คอป เปอร์ด้วยซิงค์และทินเมื่อเทียบกับซัลเฟอร์เท่ากับ 2 : 1.5 : 1.5 : 3.5 (Cu:Zn:Sn:S) และมีค่าร้อยละ ของผลิตภัณฑ์สูงที่สุด พบว่าคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟล์อัตราส่วนที่ควรจะเป็นคือ 2 : 1 : 1 : 4 แต่จากผล การทดลองพบว่าการสังเคราะห์ที่ฉายรังสีที่ 300 วัตต์ จะได้อัตราส่วนที่ใกล้เคียงที่สุด ดังนั้นแนวโน้ม ของการสังเคราะห์ โดยเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าในการฉายรังสี ควรจะใช้กำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 300 วัตต์ขึ้น ไป เพื่อที่จะได้อัตราส่วนที่เหมาะสมและค่าร้อยละผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้นใน การสังเคราะห์อนุภาค

ส่วนในกรณีของอนุภาคที่มี Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้น พบว่าอัตราส่วนค่อนข้างแตกต่างกับ CZTS ที่ กำหนดไว้คือ 2 : 1 : 1 : 4 โดยจากการทดลองพบว่ามีอัตราส่วน 2 : 1.8 : 1.5 : 3.5 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การใช้ thiourea เป็นสารตั้งต้นได้อัตราส่วนที่ดีกว่าการใช้ Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้น แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้นต้นจะได้ค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าการใช้ thiourea เป็นสารตั้งต้น โดยการ สังเคราะห์อนุภาคที่มี Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้น ควรจะหาสภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้อัตราส่วน CZTS เป็น 2 : 1 : 1 : 4

# บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

## 5.1.1 การศึกษาผลของกำลังวัตต์ที่ใช้ในการฉายรังสีไมโครเวฟต่อค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ CZTS (%yeld)

โครงงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ (Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>, CZTS) ในระบบปิดด้วยการฉายรังสีไมโครเวฟ ซึ่งอาศัยการทำปฏิกิริยาระหว่างคอปเปอร์(II)คลอไรด์, ซิงค์(II) คลอไรด์และทิน(II)คลอไรด์ โดยมีการเปรียบเทียบการใช้สารตั้งต้น 2 ตัวดังต่อไปนี้ คือ thiourea และ Na<sub>2</sub>S โดยมี Glutaraldehyde เป็นสารควบคุมขนาดอนุภาค แล้วนำสารละลายดังกล่าวไปฉายรังสี ไมโครเวฟในระยะเวลา 5 นาทีพบว่าที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ ของอนุภาคที่มี thiourea และ Na<sub>2</sub>S เป็น สารตั้งต้นมีค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์สูงที่สุดเท่ากับ 75.01% และ 105.76% ตามลำดับ และจากการที่ค่า ร้อยละของผลิตภัณฑ์ของอนุภาคที่มี Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้น มีค่าร้อยละของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 105.76% อาจเป็นเพราะว่า Na<sup>+</sup>ไปแทรกอยู่ในผลึกโดยเป็นไปได้ 2 ทาง คือไปบรรจุอยู่ที่ตำแหน่งบนผิวของผลึก หรืออีกกรณีหนึ่งคือไปแทนที่อนุภาคตัวใดตัวหนึ่งของผลึก ซึ่งอาจจะเป็นซัลไฟด์ไอออน โดยสอดคล้อง กับจำนวนซัลเฟอร์ที่น้อยอย่างมีนัยสำคัญ

## 5.1.2 การวิเคราะห์และตรวจสอบอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM)

เมื่อทำการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์(Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>, CZTS) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(SEM) อนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ (Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>, CZTS) ที่สังเคราะห์ได้ที่กำลังไฟฟ้า 100, 200 และ 300 วัตต์ ในระยะเวลา 5 นาที พบว่าอนุภาคที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้นที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ มีลักษณะเป็นโครงผลึกแบบแผ่น มี ขนาดใหญ่ ผิวมีลักษณะเป็นเกร็ดที่ซ้อนทับกันและมีรอยแตกเล็กน้อย ที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ อนุภาคที่ สังเคราะห์ได้มีขนาดเล็กลง ผิวเรียบขึ้น ส่งผลให้การผสานกันของผิวผลึกดีขึ้นและรอยแตกซัดขึ้นและที่ กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ เกร็ดมีขนาดเล็กลง ผิวของอนุภาคผสานกันของผิวผลึกดีขึ้นและรอยแตกซัดขึ้นและที่ กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ เกร็ดมีขนาดเล็กลง ผิวของอนุภาคผสานกันได้ดีมากยิ่งขึ้นลักษณะรอยแตกซัดขึ้น ส่วนอนุภาคที่มี Na<sub>2</sub>Sเป็นสารตั้งต้น พบว่ามีลักษณะแตกต่างจากอนุภาคที่มี thiourea เป็นสารตั้งต้น อย่างชัดเจน โดยพบว่าที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ผิวของอนุภาคเรียบ มีรอยแตก ที่กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์

รอยแตกเริ่มน้อยลง ความขรุขระเพิ่มขึ้น เป็นปุ่มความขรุขระที่ค่อนข้างละเอียด มีความเป็นรูพรุนขนาด เล็กและที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ พบว่าเกร็ดมีขนาดใหญ่ขึ้น ความขรุระมากขึ้น และเป็นรูพรุนขนาดใหญ่

## 5.1.3 การวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDX)

การวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDX) ของอนุภาคคอปเปอร์ซิงค์ทินไฟด์ที่สังเคราะห์ดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าอนุภาคที่ใช้ thiourea เป็นสารตั้งต้นที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ มีอัตราส่วนของการแทนที่คอปเปอร์ด้วยซิงค์และทินเมื่อเทียบ กับซัลเฟอร์สูงที่สุดเท่ากับ 2 : 1.0 : 1.3 : 4.7 (Cu:Zn:Sn:S) จากอัตราส่วนดังกล่าวพบว่ามีปริมาณของ ซัลเฟอร์ที่มากกว่า 4 ทำให้โครงผลึกเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีอนุภาคของซัลเฟอร์ที่เกินมา หรือเกิด ความไม่สมบูรณ์ของผลึกแบบ Interstitialcy ขึ้น และเข้าไปอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคที่อยู่ในโครง ผลึก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ตำแหน่งอนุภาคที่อยู่ใกล้เคียงบิดเบี้ยวไปและที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์อนุภาคที่ ใช้ Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้น พบว่ามีอัตราส่วนโมลของการแทนที่คอปเปอร์ด้วยซิงค์และทินเมื่อเทียบ กับซัลเฟอร์เท่ากับ 2 : 1.5 : 1.5 : 3.5 (Cu:Zn:Sn:S) จากอัตราส่วนดังกล่าวพบว่ามีปริมาณของซัลเฟอร์ ที่น้อยกว่า 4 มาก เนื่องจากการหายไปของซัลไฟด์ไอออนทำให้เกิดช่องว่างหรือเกิดความไม่สมบูรณ์ของ ผลึกแบบ Vacancy ขึ้น

#### 5.2 ข้อแนะนำ

5.2.1 ควรใช้เวลาในการเผาผลิตภัณฑ์ที่ 500 องศาเซเลซียสให้มากกว่า 1 ชั่วโมง

5.2.2 อนุภาคที่สังเคราะห์ได้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึกด้วย เครื่อง

X-Ray Diffraction Analysis (XRD)

5.2.3 เพิ่มกำลังไฟฟ้าในการฉายรังสีไมโครเวฟให้มากกว่า 300 วัตต์

5.2.4 การสังเคราะห์อนุภาคที่ใช้ Na<sub>2</sub>S เป็นสารตั้งต้น ควรจะหาสภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้อัตราส่วน C7TS เป็น 2 : 1 : 1 : 4

#### บรรณานุกรม

- Zou, C., Zhang, L., Lin, D., Yang, Y., Li, Q., Xu, X., . . . Huang, S. (2011). Facile synthesis of Cu2ZnSnS4 nanocrystals. *CrystEngComm*, *13*(10), 3310-3313.
- Delbos, S. (2012). Kësterite thin films for photovoltaics : a review. EPJ Photovolt., 3, 35004.
- Verma, S. k., Agrawal, V., Jain, K., Pasricha, R., & Chand, S. (2013). Green Synthesis of Nanocrystalline Cu2ZnSnS4 Powder Using Hydrothermal Route. *Journal of Nanoparticles,* 2013, 7.

Madiraju, V. A., Taneja, K., Kumar, M., & Seelaboyina, R. (2016). CZTS synthesis in

aqueous media by microwave irradiation. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, 27(4), 3152-3157.

- Wei, H., Guo, W., Sun, Y., Yang, Z., & Zhang, Y. (2010). Hot-injection synthesis and characterization of quaternary Cu2ZnSnSe4 nanocrystals. *Materials Letters, 64*(13), 1424-1426.
- Flynn, B., Wang, W., Chang, C.-h., & Herman, G. S. (2012). Microwave assisted synthesis of Cu2ZnSnS4 colloidal nanoparticle inks. *physica status solidi (a), 209*(11), 2186-2194.
- Yang, X., Xu, J., Xi, L., Yao, Y., Yang, Q., Chung, C. Y., & Lee, C.-S. (2012). Microwave-assisted synthesis of Cu2ZnSnS4 nanocrystals as a novel anode material for lithium ion battery. *Journal of Nanoparticle Research, 14*(6), 931.
- Jain, A., K. &Singla, K., R. (2011). An Overview of Microwave Assisted Technique: Green Synthesis. *Webmed Central,* 1-18
- Xia, Y., Chen, Z., Zhang, Z., Fang, X., & Liang, G. (2014). A nontoxic and low-cost hydrothermal route for synthesis of hierarchical Cu2ZnSnS4 particles. Nanoscale Research Letters, 9(1), 208.
- Guo, Q., Ford, G. M., Yang, W.-C., Walker, B. C., Stach, E. A., Hillhouse, H. W., & Agrawal, R. (2010). Fabrication of 7.2% Efficient CZTSSe Solar Cells Using CZTS Nanocrystals. *Journal of the American Chemical Society, 132*(49), 17384-17386.

- Kaigawa, R., Hirata, S., Sasaki, M., & Klenk, R. (2013). Rapid direct preparation of Cu2ZnSn(S1–x,Sex)4 films using microwave irradiation. *physica status solidi (c), 10*(7-8), 1012-1014.
- Chane-Ching, J. Y., Gillorin, A., Zaberca, O., Balocchi, A., & Marie, X. (2011). Highly-crystallized quaternary chalcopyrite nanocrystalsvia a high-temperature dissolution-reprecipitation route. *Chemical Communications*, *47*(18), 5229-5231.
- Fernandes, P. A., Salomé, P. M. P., & da Cunha, A. F. (2011). Study of polycrystalline Cu2ZnSnS4 films by Raman scattering. *Journal of Alloys and Compounds, 509*(28), 7600-7606.
- Nagoya, A., Asahi, R., Wahl, R., & Kresse, G. (2010). Defect formation and phase stability of \${\text{Cu}}\_{2}\\text{ZnSnS}}\_{4}\$ photovoltaic material. *Physical Review B, 81*(11), 113202.
- Sekou Mariama, C., Lingling, W., & Xintong, Z. (2013). Easy hydrothermal preparation of Cu 2 ZnSnS 4 (CZTS) nanoparticles for solar cell application. *Nanotechnology, 24*(49), 495401.
- Baghbanzadeh, M., Carbone, L., Cozzoli, P. D., & Kappe, C. O. (2011). Microwave-Assisted Synthesis of Colloidal Inorganic Nanocrystals. *Angewandte Chemie International Edition, 50*(48), 11312-11359.
- Wang, W., Shen, H., Jiang, F., He, X., & Yue, Z. (2013). Low-cost chemical fabrication of Cu2ZnSnS4 microparticles and film. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24*(6), 1813-1817.
- Lin, Y.-H., Das, S., Yang, C.-Y., Sung, J.-C., & Lu, C.-H. (2015). Phase-controlled synthesis of Cu2ZnSnS4 powders via the microwave-assisted solvothermal route. *Journal of Alloys and Compounds, 632*, 354-360.
- Yang, F., Ma, R., Zhao, W., Zhang, X., & Li, X. (2016). Fabrication of Cu2ZnSnS4 (CZTS) absorber films based on different compound targets. *Journal of Alloys and Compounds, 689*, 849-856.
- Jackson, P., Hariskos, D., Lotter, E., Paetel, S., Wuerz, R., Menner, R., . . . Powalla, M. (2011). New world record efficiency for Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar cells beyond 20%. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 19*(7), 894-897.
- Katagiri, H., Jimbo, K., Maw, W. S., Oishi, K., Yamazaki, M., Araki, H., & Takeuchi, A. (2009). Development of CZTS-based thin film solar cells. *Thin Solid Films, 517*(7), 2455-2460.

- Wada, T., Nakamura, S., & Maeda, T. (2012). Ternary and multinary Cu-chalcogenide photovoltaic materials from CuInSe2 to Cu2ZnSnS4 and other compounds. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 20*(5), 520-525.
- Guo, Q., Ford, G. M., Yang, W.-C., Walker, B. C., Stach, E. A., Hillhouse, H. W., & Agrawal, R. (2010). Fabrication of 7.2% Efficient CZTSSe Solar Cells Using CZTS Nanocrystals. *Journal of the American Chemical Society, 132*(49), 17384-17386.
- Guo, Q., Hillhouse, H. W., & Agrawal, R. (2009). Synthesis of Cu2ZnSnS4 Nanocrystal Ink and Its Use for Solar Cells. *Journal of the American Chemical Society, 131*(33), 11672-11673.
- Guo, Q., Kim, S. J., Kar, M., Shafarman, W. N., Birkmire, R. W., Stach, E. A., Hillhouse, H. W. (2008). Development of CuInSe2 Nanocrystal and Nanoring Inks for Low-Cost Solar Cells. *Nano Letters, 8*(9), 2982-2987.
- Tanaka, T., Kawasaki, D., Nishio, M., Guo, Q., & Ogawa, H. (2006). Fabrication of Cu2ZnSnS4 thin films by co-evaporation. *physica status solidi (c), 3*(8), 2844-2847.
- กรรณิกา แท่นคำ. (2558). คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า-คลื่นไมโครเวฟ. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ, นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติการ, สำนักความปลอดภัยแรงงาน.

สริญญา ชวพันธ์. (2555). กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดและการประยุกตใชในงาน

วัสดุศาสตร์. วารสารวิทยาศาสตรประยุกต์, 11(2), 51-58.

้บทความสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, วันที่สืบค้นข้อมูล 13 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก

http://www.nst.or.th/article/article494/article49401.html

้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, วันที่สืบค้นข้อมูล 13 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก

http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/5/microwave/index.htm วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลล์, วันที่สืบค้นข้อมูล 13 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.thaiscience.eu/2012/Tabs/Newsletter/June2555/files/ publication.pdf

#### ภาคผนวก

## สเปกตรัมการวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วย Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDX)



ตารางแสดงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ น้ำหนักของสารตามทฤษฎีและร้อยละของ ผลิตภัณฑ์ CZTS ที่กำลังไฟฟ้าต่างๆ

	เวลาในการฉาย	กำลังไฟฟ้า	น้ำหนักของผลิตภัณฑ์	ค่าร้อยละของ	สีของ
สารตั้งต้น	รังสีไมโครเวฟ	(วัตต์ )	ที่สังเคราะห์ได้	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์
	(นาที)		(กรัม)	(%yield)	
The <b>i</b> a company		100	0.2743	66.94	สีดำแกมเขียวอ่อน
Iniourea	5	200	0.2900	70.77	สีดำแกมเขียวอ่อน
		300	0.3074	75.01	สีดำแกมเขียวเข้ม
		100	0.3525	86.02	สีดำแกมเขียวอ่อน
Na <sub>2</sub> S	5	200	0.3760	91.75	สีดำแกมเขียวอ่อน
		300	0.4334	105.76	สีดำแกมเขียวเข้ม

## ตารางแสดงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ในสภาวะต่างๆ

สารตั้งต้น	เวลาในการฉาย กำลังไฟ รังสีไมโครเวฟ (วัตต์)		ร้อยละโดยน้ำหนักของ อัตรา ผลิตภัณฑ์ (At%) (mo						กำลังไฟฟ้า ร้อยละโดยน้ำา (วัตต์ ) ผลิตภัณฑ์ (			ราส่วน nol)	
	(นาท)		Cu	Zn	Sn	S	Cu	Zn	Sn	S			
							(2)	(1)	(1)	(4)			
		100	36.15	13.16	17.34	33.34	2	0.73	0.96	1.84			
Thiourea	5	200	37.75	11.76	22.53	27.97	2	0.62	1.20	1.48			
		300	21.91	11.32	14.88	51.89	2	1.03	1.36	4.74			
		100	18.57	21.08	17.22	33.13	2	2.27	1.85	3.56			
Na <sub>2</sub> 5	5	200	24.85	18.22	13.85	43.08	2	1.47	1.11	3.47			
		300	23.13	18.20	17.46	41.21	2	1.57	1.51	3.56			

#### การคำนวณหา %yieldของ CZTS

%yield = <u>น้ำหนักของสารที่สังเคราะ</u>ห์ได้ x 100 น้ำหนักของสารตามทฤษฎี

มวลโมเลกุลของ CuCl<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O = 170.48กรัมต่อโมล มวลโมเลกุลของ ZnCl<sub>2</sub> =136.28 กรัมต่อโมล มวลโมเลกุลของSnCl<sub>2</sub>•2H<sub>2</sub>O= 225.63 กรัมต่อโมล มวลโมเลกุลของ Cu = 63.55กรัมต่อโมล มวลโมเลกุลของZn = 65.38กรัมต่อโมล มวลโมเลกุลของSn = 118.69กรัมต่อโมล มวลโมเลกุลของS = 32.06กรัมต่อโมล

เช่นน้ำหนักที่ชั่งได้ของ CZTS ที่มี Thiourea เป็นสารตั้งต้น ที่กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ระยะเวลา 5 นาที = 0.2743 กรัม

%yield = <u>0.2743 × 100</u> = 66.94 0.409

## การคำนวณหาปริมาณองค์ประกอบของอนุภาค

ที่กำลังไฟฟ้า 100วัตต์ ระยะเวลา 5 นาที มีร้อยละโดยน้ำหนักของคอปเปอร์ ซิงค์ ทิน และซัลไฟด์ เท่ากับ 36.44%, 13.69%, 32.75% และ 17.01%

จากสูตร	molของCu	=	%Wt ของ Cu		
			น้ำหนักโมเลกุลจ		
จะได้	molของ Cu	=	36.44	=	0.5734
			63.55		
	molของ Zn	=	0.2094		
	molของSn	=	0.2759		
	molของ S	=	0.5306		

จะได้ Cu : Zn : Sn: S = 0.5734 : 0.2094 : 0.2759 : 0.5306 เนื่องจากปริมาณของคอปเปอร์สามารถแทนที่ได้หมด จึงกำหนดให้คอปเปอร์คงที่ โดยนำโมลของแต่ละอนุภาคคูณ 2แล้วนำไปหารด้วยโมลของ Cu ทั้งหมด จาก = 0.5734 x 2 : 0.2094 x 2 : 0.2759 x 2 : 0.2094 x 2 0.5734 0.5734 0.5734 0.5734

จะได้ Cu :Zn : Cd : S = 2 : 0.73 : 0.96 : 1.84